

TDSEMIC

拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障

WEB | WWW.TDSEMIC.COM



電源管理



顯示驅動



二三極管



LDO穩壓器



觸摸芯片



MOS管



運算放大器



存儲芯片



MCU



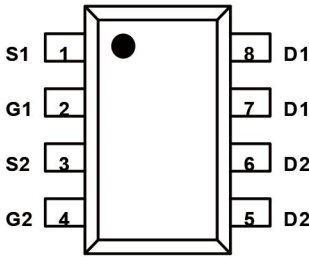
串口通信

9926-TD

產品規格說明書

9926A
20VN 沟道增强型 MOS 场效应管

$R_{DS(ON)}, V_{GS}@2.5V, I_{DS}@5.0A = 42m\Omega$
 $R_{DS(ON)}, V_{GS}@4.5V, I_{DS}@6.0A = 30m\Omega$



SOP-8

绝对最大额定值（ $T_A=25^{\circ}C$ ，除非另有注明）

参数		符号	最大值	单位
漏源极电压		V_{DS}	20	V
栅源极电压		V_{GS}	± 10	V
连续漏电流	$T_A=25^{\circ}C$	I_D	6	A
	$T_A=70^{\circ}C$		4.2	
脉冲漏电流		I_{DM}	20	
功耗	$T_A=25^{\circ}C$	P_D	2	W
	$T_A=70^{\circ}C$		1.28	
温度范围		T_J, T_{STG}	-55~150	$^{\circ}C$

热特性

参数		符号	典型值	最大值	单位
最大管结温度	$T \leq 10S$	$R_{\theta JA}$	56	62.5	$^{\circ}C/W$
最大管结温度	Steady -State		81	110	$^{\circ}C/W$
最大热阻	Steady -State	$R_{\theta JL}$	40	48	$^{\circ}C/W$

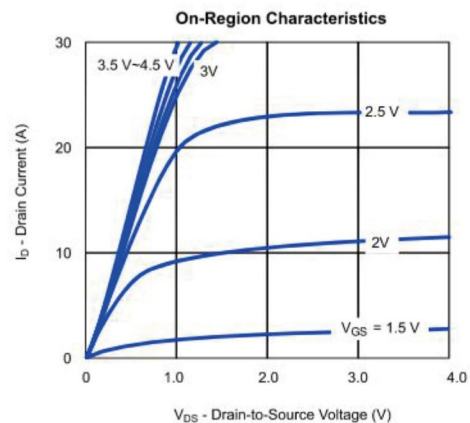
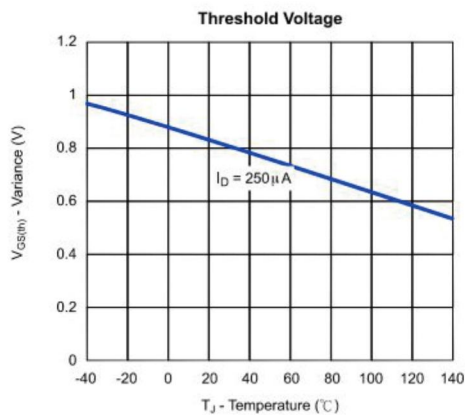
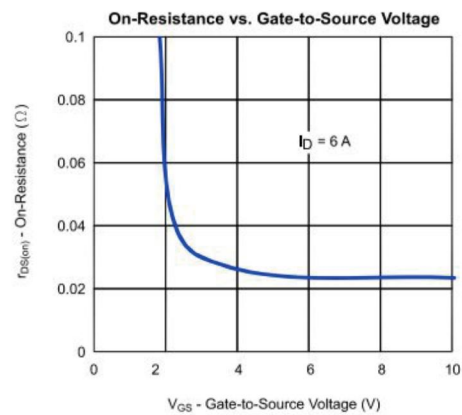
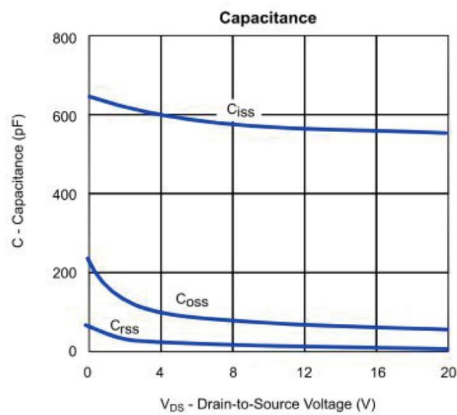
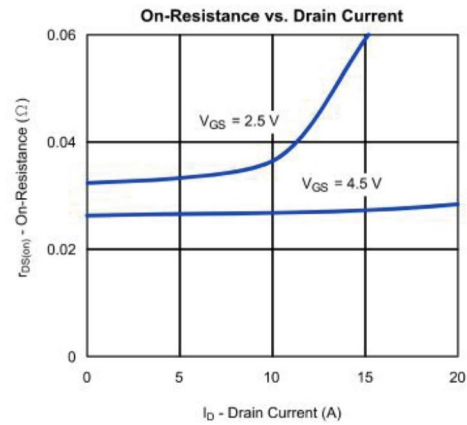
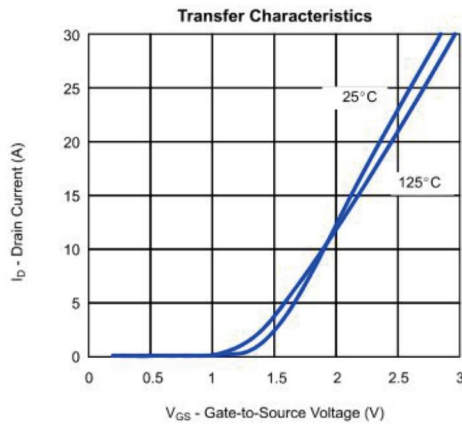
电特性

($T_J=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有注明)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
静态部分						
漏源击穿电压	BV _{DSS}	V _{GS} = 0V,I _D = 250uA	20			V
Drain-source 导通内阻	R _{DS(ON)}	V _{GS} = 4.5V,I _{DS} =6A		21	30	m Ω
Drain-source 导通内阻	R _{DS(ON)}	V _{GS} = 2.5V,I _{DS} =5A		26	42	m Ω
栅极阈值电压	V _{GS(th)}	V _{GS} = V _{GS} ,I _D = 250uA	0.5	0.75	1	V
漏源极漏电流	I _{DSS}	V _{DSS} = 20V,V _{GS} = 0V			1	uA
栅源极漏电流	I _{GSS}	V _{GS} = ±12V,V _{DS} = 0V			±100	nA
动态部分						
栅极总电荷	Q _G	V _{DS} = 10V,I _D = 6A V _{GS} = 4.5V		6.24	8.11	nC
栅源电荷	Q _{GS}			1.64	2.13	
栅漏电荷	Q _{GB}			1.34	1.74	
开始延迟时间	T _{d(on)}	V _{DD} = 10V,I _D = 6A I _D = 1A,V _{GS} = 4.5V		10.4	20.8	ns
上升时间	T _r			4.4	8.8	
关闭延迟时间	T _{d(off)}			27.36	54.72	
下降时间	T _f			4.16	8.32	
输入电容	C _{iss}	V _{DS} = 8V,V _{GS} = 0V f =1.0MHz		522.3		pF
输出电容	C _{oss}			98.48		
反向传输电容	C _{rss}			74.69		
源漏极二极管						
二极管最大正向电流	I _S				1.7	A
二极管正向电压	V _{SD}	I _S = 1.7A,V _{GS} = 0V		0.74		V

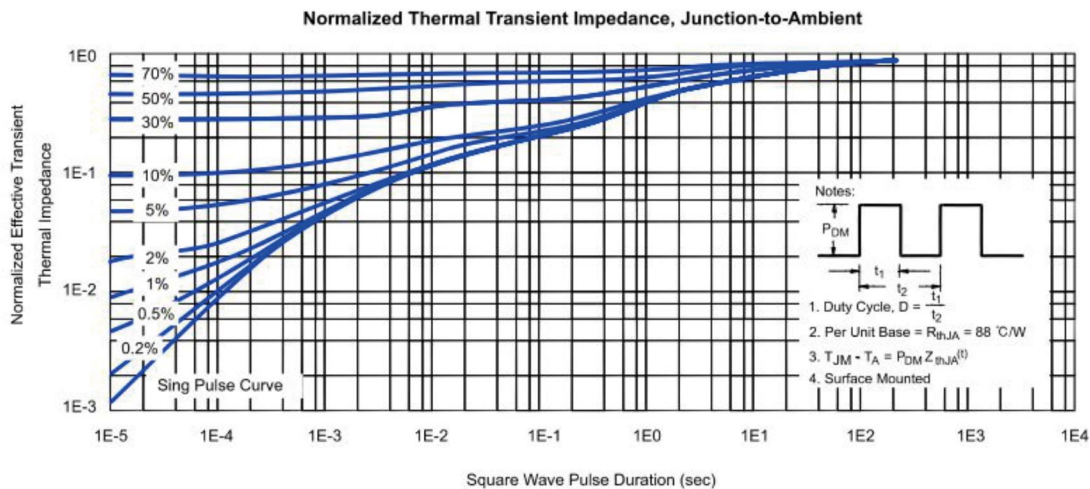
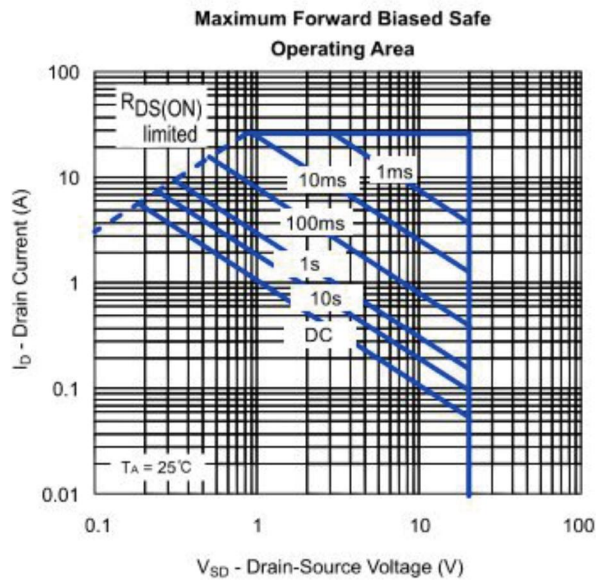
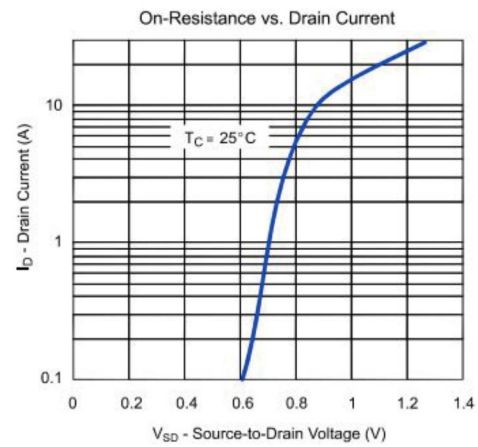
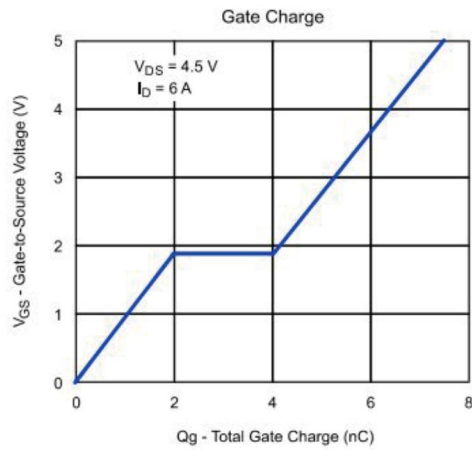
曲线图

Typical Characteristics (T_J = 25°C Noted)



9926A 20VN 沟道增强型 MOS 场效应管

Typical Characteristics (T_J = 25°C Noted)



包装尺寸

SOP-8 Package Outline

